

■シンポジウム一覧

開催日	時間	会場	テーマ	世話人(所属)
9/4 (火)	9:00～16:25	G棟 2F-G201 F会場 (29)	フラーレン系低次元ナノマテリアル研究の最前線	宮澤 薫一(物 材 機 構) 藤田 大介(物 材 機 構) 北澤 英明(物 材 機 構) 若原 孝次(物 材 機 構)
	9:30～17:30	G棟 3F-G307 X会場 (29)	X線・中性子による quick 反射率法の展望 - 表面や埋もれたナノ構造の変化を追う(III)	桜井 健次(物 質・材 料 研 究 機 構)
	13:00～17:00	2号館 4F-2401 ZN会場 (29)	ナノインプリント樹脂材料の開発最前線	古室 昌徳(N E D O)
	13:00～17:20	2号館 5F-2501 ZQ会場 (29)	薄膜・表面物理分科会企画「ナノスケール構造制御技術の最前線」- ACSIN-9 プレシンポジウム-	本間 芳和(東 理 大) 重川 秀実(筑 波 大 院)
	13:30～17:45	G棟 2F-G204 L会場 (29)	結晶工学分科会・応用電子物性分科会共同企画 「実用化の始まった化合物太陽電池」	和田 隆博(龍 谷 大) 山田 明(東 工 大)
9/5 (水)	13:00～16:50	G棟 3F-G301 R会場 (30)	微細周期構造をもつ光学素子の新展開	菊田 久雄(大 阪 府 大) 樋田 博文(オ リ ン パ ス)
	13:00～17:10	G棟 2F-G205 M会場 (30)	光と半導体による新しいエネルギー生成と環境浄化	大川 和宏(東 理 大) 伊藤 隆(東 北 大) 藤井 克司(東 北 大)
	13:00～17:20	G棟 4F-G403 ZD会場 (30)	放射線知識普及活動の最前線	福田 和悟(大 阪 産 業 大) 奥田 修一(大 阪 府 大)
	13:00～17:25	2号館 4F-2401 ZN会場 (30)	機能デバイスを支えるシリコン結晶基盤技術 -一次世代 ULSI から環境デバイスまで-	金田 寛(新 潟 大) 小野 春彦(神 奈 川 産 技 セ 立) 村上 進(日 立)
	13:15～17:30	G棟 1F-G102 B会場 (30)	フォトニックネットワークに向けた中核光デバイス群の開発と光ラベル スイッチングノードプロトタイプへの応用	中野 義昭(東 大)
	13:00～17:30	2号館 5F-2501 ZQ会場 (30)	High-k メタルゲートスタックにおける閾値のプロセス依存性と制御の現状	山田 啓作(早 大) 白石 賢二(筑 波 大)
	13:00～17:35	5号館 1F-5106 ZR会場 (31)	「窒化物の新展開」特定領域研究企画 「窒化物光半導体のフロンティア」-材料潜在能力の極限発現-	名西 徳之(立 命 館 大)
	13:00～17:50	G棟 1F-G103 C会場 (31)	プログラム自己組織化を用いた分子スケールデバイス -ボトムアップ/トップダウン融合の視点から-	松本 卓也(阪 大)
	13:00～17:20	G棟 2F-G202 H会場 (31)	実用化の立場からみたソフトマテリアル	中嶋 健(東 工 大) 多田 和也(兵 庫 県 立 大) 金藤 敬一(九 工 大)
	13:00～18:00	G棟 2F-G203 K会場 (31)	Poly-Si TFT 最近の展開と今後	部家 彰(兵 庫 県 立 大)
	13:10～17:30	G棟 2F-G206 N会場 (31)	電磁場下における様々な現象とその制御-固体金属から流体まで-	岩井 一彦(名 大) 山本 勲(横 浜 国 大)
	13:30～17:00	G棟 3F-G309 ZA会場 (32)	転換期のもの作り人材育成の現状と課題 ～高校・高専・大学・企業の視点を中心にして～	安藤 静敏(東 理 大)
9/6 (木)	13:00～16:45	2号館 3F-2322 ZL会場 (32)	日本学術振興会第 161 委員会企画 「半導体バルク結晶技術の現状と展望」	藤岡 洋(東 大)
	13:00～17:00	5号館 1F-5106 ZR会場 (32)	結晶工学分科会企画シンポジウム 「蛍光体結晶でつくる大画面ディスプレイと白色 LED の性能改善」	田中 克(N H K)
	13:00～17:15	G棟 1F-G103 C会場 (32)	シリコン・フォトニクス技術の最新動向	美野 真司(N T T フォトニクス研)
	13:00～17:30	G棟 1F-G104 D会場 (32)	有機デバイスの物性評価と有機 FET の新展開(基礎編)	山田 俊樹(情 通 機 構) 島田 敏宏(東 大) 塚越 一仁(理 研) 竹谷 純一(阪 大)
	13:00～17:30	G棟 4F-G404 ZE会場 (32)	先端 LSI に与える放射線の影響 “ソフトエラーとハードエラー”	廣瀬 和之(宇 宙 研) 戸坂 義春(富 士 通)
	13:25～17:45	G棟 3F-G303 S会場 (33)	ナノスピントロニクスにおける量子効果と関連現象	宗片比呂夫(東 工 大) 高橋 茂樹(東 芝)
9/7 (金)	9:00～12:25	G棟 2F-G203 K会場 (33)	ランダム系フォトエレクトロニクス研究会 「ランダム系材料・デバイスの挑戦、結晶系を超えられるか!？」	藤原 巧(東 北 大 院)
	10:15～16:05	G棟 4F-G405 ZF会場 (33)	活用広がる機能性高密度流体プロセス	近藤 英一(山 梨 大) 新宮原正三(関 西 大)
	13:00～16:25	3号館 3F-3305 ZV会場 (33)	薄膜シリコン太陽電池の新展開	外山 利彦(阪 大 院)
	13:00～17:15	5号館 1F-5106 ZR会場 (33)	有機デバイスの物性評価と有機 FET の新展開(応用編)	山田 俊樹(情 通 機 構) 島田 敏宏(東 大) 越 一仁(理 研) 竹谷 純一(阪 大)
	13:30～17:20	G棟 1F-G104 D会場 (33)	バイオチップの現状と課題 ～企業での開発研究の視点から～	吉信 達夫(東 北 大 院) 中村 史夫(東 大)
	13:45～17:25	2号館 5F-2501 ZQ会場 (34)	プラズマとその応用プロセスのシミュレーション -現状とさらなる飛躍に向けて-	中村 圭二(中 部 大)

() 内の数字はプログラム掲載頁。

■ 11. 半導体A (シリコン) 分科内総合講演 「LSI 多層配線の微細化限界とブレイクスルー技術」 (招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/6 (木)	10:00 ~ 10:10	2号館 5F-2501 ZQ会場 (81)	イントロダクトリートーク	蓮沼 正彦 (東 芝)
	10:10 ~ 11:00		配線の微細化と信頼性課題	上野 和良 (芝 浦 工 大)
	11:10 ~ 11:40		ポーラス Low-k 絶縁膜に CuMn 合金自己形成バリア技術を適用した Cu Dual-Damascene 配線	渡部 忠兆 (東 芝 セ ミ コ ン 社)
	11:40 ~ 12:10		高配向 PVD-Ru(001) ライナー上直接 Cu めっきによる低抵抗 Cu 配線形成技術	植木 誠 (N E C)
	13:15 ~ 13:45		微細化に対する金属学的なバリア層形成手法	伊藤 和博 (京 大 工)
	13:45 ~ 14:15		配線抵抗率のサイズ効果と RC 遅延	北田 秀樹 (富 士 通 研)
	14:15 ~ 14:45		微細 Cu 配線のエレクトロマイグレーション: 信頼性と抵抗率のトレードオフ	横川 慎二 (N E C エレクトロニクス)
	14:45 ~ 15:15		Cu SIV 信頼性における多数個ビアレイアウト効果	柴田 隆二 (ルネサステクノロジー)
	15:30 ~ 16:00		ダマシンプロセスを適用したカーボンナノチューブ配線ビアの電気伝導特性	二瓶 瑞久 (半導体先端テクノロジーズ)
	16:00 ~ 16:30		シリコン貫通電極を形成した積層チップ間の常温接続技術	田中 直敏 (日 立)
16:30 ~ 17:00	「グローバル配線」オンチップ伝送線路配線技術	伊藤 浩之 (東 工 大)		

■ 14. 非晶質・微結晶分科内総合講演 「非晶質・微結晶材料における未知物性の開拓」 (招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/6 (木)	13:30 ~ 13:45	3号館	イントロダクトリートーク: 非晶質・微結晶材料における未知物性の開拓	内野 隆司 (神 戸 大 理)
	13:45 ~ 14:30	3F-3305	微結晶透明縮退半導体の自由キャリアの奇妙なふるまい	嶋川 晃一 (岐 阜 大 工)
	14:30 ~ 15:15	ZV 会場	VIb 族ガラスの光誘起現象 - 新応用の可能性 -	田中 啓司 (北 大 工)
	15:30 ~ 16:15	(104)	酸化物の構造の乱れと光・電子物性	細野 秀雄 (東 工 大)

■ 12 半導体B (探索的材料・デバイス) 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/4 (火)	15:45 ~ 16:15	G棟 2F-G203 K会場 (93)	AlGaIn/GaN HFET の開発と評価技術-トラップの功罪-	名西 徳之 (立 命 館 大)
9/6 (木)	9:00 ~ 9:30	G棟 2F-G204 L会場 (95)	Si-APD と 2 光子吸収と光計測への応用	香川 俊明 (湘 南 工 科 大)

■有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/5 (水)	13:30 ~ 13:45	G棟 1F-G104 D会場 (79)	低電圧・大電流動作可能な縦型メタルベース有機トランジスタ	中山 健一 (山 形 大 院 理 工)

■プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/7 (金)	13:15 ~ 13:45	2号館 5F-2501 ZQ会場 (34)	表面波プラズマによる薄膜プロセスの新展開	菅井 秀郎 (名 大 工)

■アジアの研究者招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者 (所属)
9/4 (火)	13:30 ~ 14:00	G棟 3F-G309 ZA会場 (37)	フレキシブル電子デバイスのためのプラズマ技術開発	Jeon G. Han (Sungkyunkwan Univ.)
9/6 (木)	13:00 ~ 13:30	G棟 3F-G301 R会場 (40)	A partial compensation lens method and its application in aspheric surface testing	Qun Hao (Beijing Institute of Technology)
9/7 (金)	12:45 ~ 13:15	G棟 2F-G201 F会場 (45)	Technology Integration Line (TIL) and Shen Guang-III Laser for Inertial Fusion Research in China	Feng Jing (Research Center of Laser Fusion, CAEP, China)

() 内の数字はプログラム掲載頁。